

1. 概述

HM5410G,内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。

本 IC 适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

2. 特点

HM5410G 具备如下特点:

(1) 高精度电压检测电路

•	过充电检测电压	4.280V	精度±40mV
•	过充电释放电压	4.080V	精度±50mV
•	过放电检测电压	2.500V	精度±80mV
•	过放电释放电压	3.000V	精度±80mV
•	放电过流检测电压	150mV	精度±30mV
•	充电过流检测电压	-150mV	精度±50mV
•	负载短路检测电压	0.85V(固定)	精度±300mV

(2) 各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)

● 过充电检测延迟时间
● 过放电检测延迟时间
● 放电过流检测延迟时间
● 充电过流检测延迟时间
● 负载短路检测延迟时间
典型值 10ms
典型值 12ms
典型值 500µs

- (3) 休眠功能: 有
- (4) 低耗电流

● 工作模式 典型值 3.0µA, 最大值 6.0µA (VDD=3.9V)

● 休眠模式 最大值 0.1µA (VDD=2.0V)

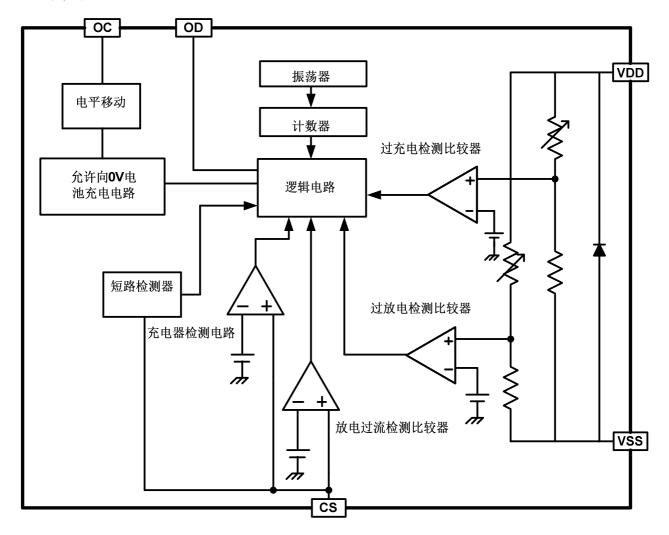
- (5) 连接充电器的端子采用高耐压设计(CS 端子和 OC 端子,绝对最大额定值是 20V)
- (6) 向 OV 电池充电功能: 允许
- (7) 宽工作温度范围: -40℃~+85℃
- (8) 小型封装: SOT-23-6
- (9) 无卤素绿色环保产品

3. 应用

- 1节锂离子可再充电电池组
- 1节锂聚合物可再充电电池组



4. 方框图



5. 订购信息

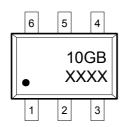
● 产品名称定义





6. 封装、脚位及标记信息

脚位	符号	说明
1	OD	放电控制用 MOSFET 门极连接端子
2	CS	过电流检测输入端子,充电器检测端子
3	OC	充电控制用 MOSFET 门极连接端子
4	NC	无连接
5	VDD	电源端,正电源输入端子
6	VSS	接地端,负电源输入端子



10: 产品名称

GB: 产品序列号及封装名称

XXXX: 生产识别码

7. 绝对最大额定值

(VSS=0V,Ta=25℃,除非特别说明)

项目	符号	规格	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	V_{DD}	VSS-0.3~VSS+10	V
OC 输出端子电压	V _{OC}	VDD-20~VDD+0.3	V
OD 输出端子电压	V_{OD}	VSS-0.3~VDD+0.3	V
CS 输入端子电压	V _{CS}	VDD-20~VDD+0.3	٧
工作温度范围	T _{OP}	-40~+85	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
储存温度范围	T _{ST}	-40~+125	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
容许功耗	P_D	250	mW



8. 电气特性

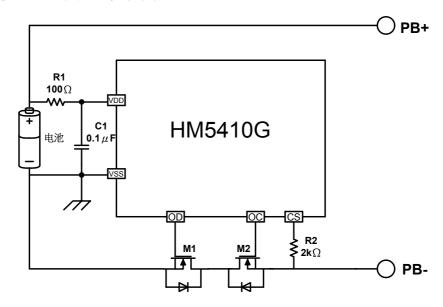
(VSS=0V, Ta=25℃, 除非特别说明)

项目 符号		条件	最小值	典型值	最大值	单位					
		输入电压									
VDD-VSS 工作电压	V_{DSOP1}	-	1.5	-	8	V					
VDD-CS 工作电压	V_{DSOP2}	-	1.5	-	20	V					
	耗电流										
工作电流	I_{DD}	VDD=3.9V	-	3.0	6.0	μA					
休眠电流	I_{PD}	VDD=2.0V	-	-	0.1	μΑ					
		检测电压									
过充电检测电压	V		4.240	4.280	4.320	V					
过光电位测电压	V _{CU}	-5℃~55℃ (*1)	4.230	4.280	4.330	V					
过充电释放电压	V_{CR}		4.030	4.080	4.130	V					
过放电检测电压	V_{DL}		2.420	2.500	2.580	٧					
过放电释放电压	V_{DR}		2.920	3.000	3.080	V					
放电过流检测电压	V_{DIP}	V _{DD} =3.6V	120	150	180	mV					
充电过流检测电压	V_{CIP}	V _{DD} =3.6V	-200	-150	-100	mV					
负载短路检测电压	V_{SIP}	V _{DD} =3.0V	0.55	0.85	1.15	V					
		延迟时间									
过充电检测延迟时间	T_OC	V_{DD} =3.9V \rightarrow 4.5V	50	100	150	ms					
过放电检测延迟时间	T_OD	V_{DD} =3.6V \rightarrow 2.0V	10	25	40	ms					
放电过流检测延迟时间	T_DIP	V _{DD} =3.6V	5	10	15	ms					
充电过流检测延迟时间	T_{CIP}	V _{DD} =3.6V	6	12	18	ms					
负载短路检测延迟时间	T_{SIP}	V _{DD} =3.0V	-	500	700	μs					
		控制端子输出电压									
OD 端子输出高电压	V_{DH}		VDD-0.1	VDD-0.02	1	V					
OD 端子输出低电压	V_{DL}		-	0.1	0.5	V					
OC 端子输出高电压	V_{CH}		VDD-0.1	VDD-0.02	-	V					
OC 端子输出低电压	V_{CL}		-	0.1	0.5	V					
	ļī	句 0V 电池充电的功能(允	许)								
充电器起始电压(允许 向 0V 电池充电功能)	V_{0CH}	允许向 0V 电池充电功能	0.0	0.7	1.2	V					

说明: *1、此温度范围内的参数是设计保证值,而非高、低温实测筛选。



9. 电池保护 IC 应用电路示例



标记	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定VDD、加强ESD	100Ω	100Ω	470Ω	*1
R2	电阻	限流	300Ω	2kΩ	2kΩ	*2
C1	电容	滤波,稳定VDD	0.01µF	0.1μF	1.0µF	*3
M1	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	*4
M2	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	*5

- *1、R1连接过大电阻,由于耗电流会在R1上产生压降,影响检测电压精度。当充电器反接时,电流从充电器流向IC,若R1过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。
- *2、R2连接过大电阻,当异常大电流充电时,可能导致不能切断充电回路。但为控制充电器 反接时的电流,请尽可能选取较大的阻值。
- *3、C1有稳定VDD电压的作用,请不要连接0.01uF以下的电容。
- *4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时,可能导致在过放电保护之前停止放电。
- *5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时,N-MOSFET有可能被损坏。

注意:

- (1) 上述参数有可能不经预告而作更改,请及时到本公司网站下载最新版规格书。
- (2) 外围器件如需调整,建议客户进行充分的评估和测试。



10.工作说明

10.1. 正常工作状态

此 IC 持续侦测连接在 VDD 和 VSS 之间的电池电压,以及 CS 与 VSS 之间的电压差,来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(V_{CL})以上并在过充电检测电压(V_{CL})以下,且 CS 端子电压在充电过流检测电压(V_{CIP})以上并在放电过流检测电压(V_{DIP})以下时,IC 的 OC 和 OD 端子都输出高电平,使充电控制用 MOSFET 和放电控制用 MOSFET 同时导通,这个状态称为"正常工作状态"。此状态下,充电和放电都可以自由进行

注意: 初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接 CS 端子和 VSS 端子,或者连接充电器,就能恢复到正常工作状态。

10.2. 过充电状态

正常工作状态下的电池,在充电过程中,一旦电池电压超过过充电检测电压(V_{CU}),并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(T_{OC})以上时,HM5410G会关闭充电控制用的 MOSFET(OC 端子),停止充电,这个状态称为"过充电状态"。

过充电状态的释放,有以下两种方法:

- (1)由于自放电使电池电压降低到过充电释放电压(V_{CR})以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。
- (2)移走充电器并连接负载,当电池电压降低到过充电检测电压(V_{CU})以下时,过充电状态释放,恢复到正常工作状态。

10.3. 过放电状态

正常工作状态下的电池,在放电过程中,当电池电压降低到过放电检测电压(V_{DR})一下,并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(T_{OD})以上时,HM5410G 会关闭放电控制用的 MOSFET(OD 端子),停止放电,这个状态称为"过放电状态"。

当关闭放电控制用 MOSFET 后,CS 由 IC 内部电阻上拉到 VDD,使 IC 耗电流减小到休眠时的耗电流值,这个状态称为"休眠状态"。

过放电状态的释放,有以下两种方法:

- (1)连接充电器,若 CS 端子电压低于充电过流检测电压(V_{CIP}),当电池电压高于过放电检测电压(V_{DI})时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。
- (2) 连接充电器,若 CS 端子电压高于充电过流检测电压(V_{CIP}),当电池电压高于过放电释放电压(V_{DR})时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。

10.4. 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能)

正常工作状态下的电池,HM5410G 通过检测 CS 端子电压持续侦测放电电流。一旦 CS 端子电压超过放电过流检测电压(V_{DIP}),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间(T_{DIP}),则关闭放电控制用的 MOSFET(OD 端子),停止放电,这个状态称为"放电过流状态"。

而一旦 CS 端子电压超过负载短路检测电压(V_{SIP}),并且这种状态持续的时间超过负载



短路检测延迟时间(T_{SIP}),则也关闭放点控制用的 MOSFET (OD 端子),停止放电,这个状态称为"负载短路状态"。

连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的阻抗大于"自动释放阻抗", CS端子电压在放电过流检测电压(V_{DIP})以下时,放电过流状态释放。

10.5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池,在充电过程中,如果 CS 端子电压低于充电过流检测电压(V_{CIP}),并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间(T_{CIP}),则关闭充电控制用的 MOSFET(OC 端子),停止充电,这个状态称为"充电过流状态"。

进入充电过流检测状态后,如果断开充电器使得 CS 端子电压高于充电过流检测电压 (V_{CIP}) 时,充电过流状态被解除,恢复到正常工作状态。

10.6. 向 0V 电池充电功能(允许)

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极(PB+)和电池负极(PB-)之间的充电器电压,高于"向 0V 电池充电的充电器起始电压(V_{OCH})"时,充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位,由于充电器电压使 MOSFET 的门极和源极之间的电压差高于其导通电压,充电控制用 MOSFET 导通(OC 端子),开始充电。这时,放电控制用 MOSFET 仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压(V_{DL})时,HM5410G 进入正常工作状态。

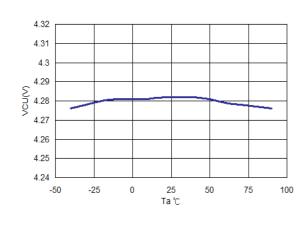
注意:

- (1) 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商,确认所购买的电池是否具备"允许向 0V 电池充电"的功能,还是"禁止向 0V 电池充电"的功能。
- (2) "允许向 0V 电池充电功能"比"异常充电电流检测功能"优先级更高。因此。使用"允许向 0V 电池充电"功能的 IC,在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压(V_{DL})以下时,不能检测异常充电电流。

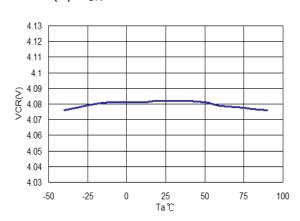


11.特性(典型数据)

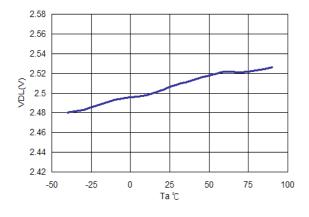
- **11.1.** 过充电检测电压/过充电释放电压,过放电检测电压/过放电释放电压,放电过流检测电压/负载短路检测电压以及各延迟时间
 - (1) V_{CU} vs. Ta



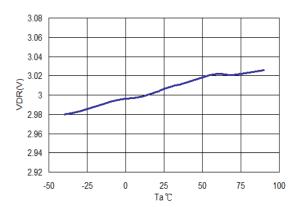
(2) V_{CR} vs. Ta



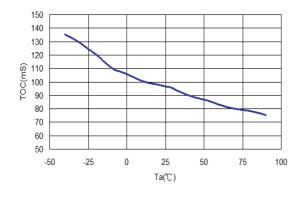
(3) V_{DL} vs. Ta



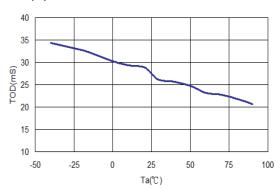
(4) V_{DR} vs. Ta



(5) T_{OC} vs. Ta

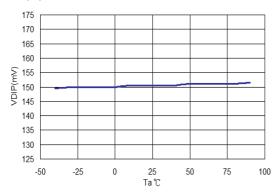


(6) T_{OD} vs. Ta

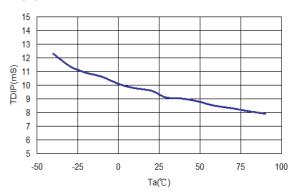




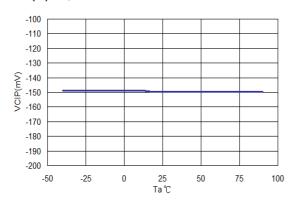




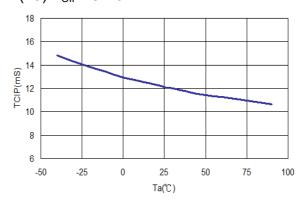
(8) T_{DIP} vs. Ta



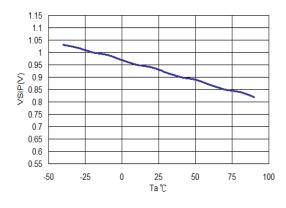
(9) V_{CIP} vs. Ta



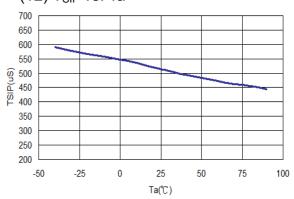
(10) T_{CIP} vs. Ta



(11) V_{SIP} vs. Ta



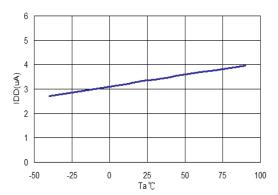
(12) T_{SIP} vs. Ta



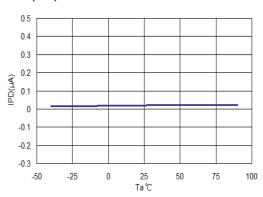


11.2. 耗电流

(13) I_{DD} vs. Ta



(14) I_{PD} vs. Ta

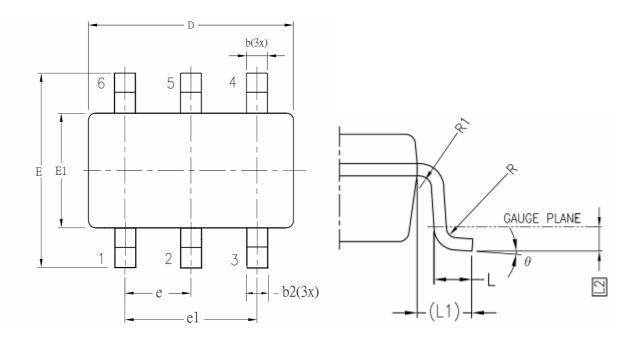




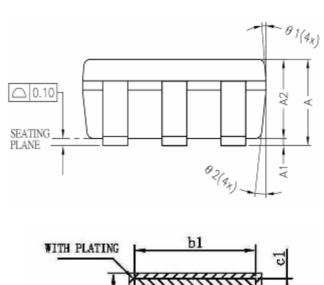
12.封装信息

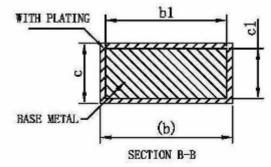
12.1.SOT-23-6 封装

说明:单位为 mm。



SYM		. DIMENSION MILLIMETER	_						
BOL	MINIMUM	NOMINAL	_						
Α	-	1.30	1.40						
A1	0	-	0.15						
A2	0.90	1.20	1.30						
b	0.30	-	0.50						
b1	0.30	0.40	0.45						
b2	0.30	0.40	0.50						
С	0.08	-	0.22						
c1	0.08	0.13	0.20						
D	2.90 BSC								
Е		2.80 BSC							
E1		1.60 BSC							
е		0.95 BSC							
e1		1.90 BSC							
L	0.30	0.45	0.60						
L1		0.60 REF							
L2		0.25 BSC							
R	0.10	-	-						
R1	0.10	-	0.25						
θ	0°	4°	8°						
θ1	5°	-	15°						
θ2	5°	-	15°						





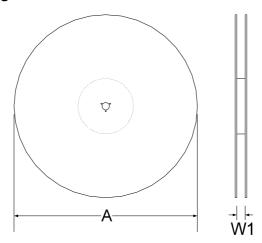


13. Tape & Reel 信息

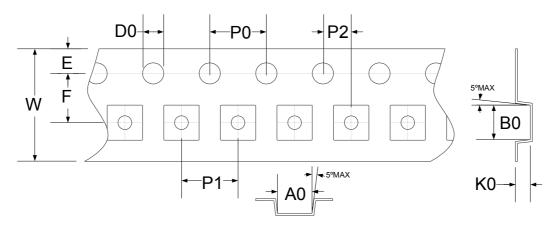
13.1. Tape & Reel 信息---SOT-23-6 (样式一)

说明:单位为 mm。

13.1.1. Reel Dimensions



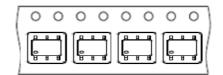
13.1.2. Carrier Tape Dimensions



SYMBOLS	Reel Dimensions		Carrier Tape Dimensions									
	Α	W1	A0	В0	K0	P0	P1	P2	Е	F	D0	W
Spec.	178	9.0	3.30	3.20	1.50	4.00	4.00	2.00	1.75	3.50	1.50	8.00
Tolerance	±0.50	+1.50/-0	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.05	±0.10	±0.05	+0.1/-0	±0.20

Note: 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance is ±0.20mm.

13.1.3. Pin1 direction

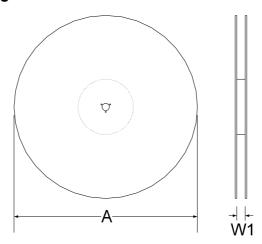




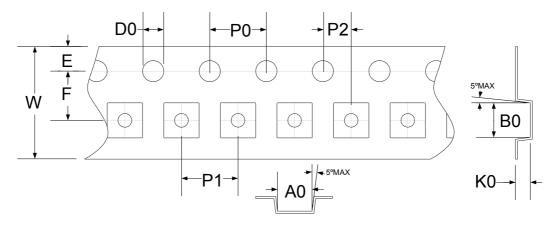
13.2. Tape & Reel 信息---SOT-23-6(样式二)

说明:单位为 mm。

13.2.1. Reel Dimensions



13.2.2. Carrier Tape Dimensions



	Re	eel					`arriar T	ana Din	noncion	<u> </u>		
SYMBOLS	Dimer	nsions	Carrier Tape Dimensions									
	Α	W1	A0	В0	K0	P0	P1	P2	Е	F	D0	W
Spec.	178	9.4	3.17	3.23	1.37	4.00	4.00	2.00	1.75	3.50	1.55	8.00
Tolerance	±2.00	±1.50	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.05	±0.10	±0.05	±0.05	+0.30/-0.10

Note: 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance is ±0.20mm.

13.2.3. Pin1 direction

